



Shanghai Xinkehui New Material Co., Ltd.

8 英寸
导电型

SiC 衬底
产品标准

等级	精选级 (Z 级)	测试级 (D 级)
直径	199.5 mm ~ 200.0 mm	199.5 mm ~ 200.0 mm
晶型	4H	4H
厚度	500 μm $\pm$ 25 μm	500 μm $\pm$ 25 μm
晶片方向	向 <11 $\bar{2}$ 0> 偏转 4.0° $\pm$ 0.5°	向 <11 $\bar{2}$ 0> 偏转 4.0° $\pm$ 0.5°
微管密度	$\leq 0.2 \text{ cm}^{-2}$	$\leq 5 \text{ cm}^{-2}$
电阻率	0.015 ~ 0.025 $\Omega\cdot\text{cm}$	0.015 ~ 0.028 $\Omega\cdot\text{cm}$
Notch 晶向	{10-10} $\pm 5.0^\circ$	{10-10} $\pm 5.0^\circ$
边缘去除	3 mm	3 mm
局部厚度变化 / 总厚度变化 / 弯曲度 / 翘曲度	$\leq 5 \mu\text{m}$ / $\leq 10 \mu\text{m}$ / $\pm 35 \mu\text{m}$ / 70 μm	$\leq 10 \mu\text{m}$ / $\leq 15 \mu\text{m}$ / $\pm 50 \mu\text{m}$ / 100 μm
表面粗糙度	抛光 Ra $\leq 1 \text{ nm}$	抛光 Ra $\leq 1 \text{ nm}$
	CMP Ra $\leq 0.2 \text{ nm}$	CMP Ra $\leq 0.5 \text{ nm}$
边缘裂纹 (强光灯观测)	—	累计长度 $\leq 30 \text{ mm}$ 单个长度 $\leq 2 \text{ mm}$
六方空洞 (强光灯观测)	累积面积 $\leq 0.05\%$	累积面积 $\leq 0.1\%$
多型 (强光灯观测)	—	累积面积 $\leq 3\%$
目测包裹物 (日光灯观测)	累积面积 $\leq 0.05\%$	累积面积 $\leq 3\%$
硅面划痕 (强光灯观测)	—	累计长度 $\leq 1 \times$ 晶圆直径
崩边 (强光灯观测)	不允许宽度 $\geq 0.2\text{mm}$, 深度 $\geq 0.2\text{mm}$	≤ 9 个, 每个 $\leq 1 \text{ mm}$
穿透螺位错 (TSD)	$\leq 300 \text{ cm}^{-2}$	—
硅面污染物 (强光灯观测)	—	—
包装	多片卡塞 / 单片盒包装	多片卡塞 / 单片盒包装

Name: Doris Li

Tel: +86-187-0175-6522 (whatsapp or skype is available)

+86-153-1422-5837(Wechat)

Email:doris@xkh-semitech.com

Company: Shanghai Xinkehui New Material Co., Ltd